FORMATION OF THIN FILM

Publication number: JP60238304 (A) Publication date: 1985-11-27

Inventor(s):

1900-11-27

Applicant(s):

SHINOHARA KOUICHI

Classification:
- international:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

C08F2/00; C08F2/52; C08F2/54; C08G85/00; C23C14/12; G11B5/84; G11B5/85; C08F2/00; C08F2/46; C08G85/00; C23C14/12; G11B5/84; G11B5/85; (IPC1-7): C08F2/52;

C08G85/00; G11B5/85

- European:

Application number: JP19840093409 19840510 Priority number(s): JP19840093409 19840510

Abstract of JP 60238304 (A)

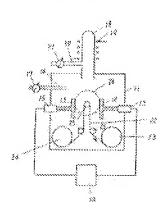
PURPOSE:To produce a thin film useful as a protective film of magnetic recording medium, etc., continuously, at an extremely high speed, by forming a plasma- polymerized film in the state attained by mixing ionized gas generated by electrodeless discharge to the atmosphere of glow discharge generated by opposite electrodes. CONSTITUTION:Ionized gas generated in the electrodeless discharge vessel 18 by the electrodeless discharge of at least a monomer gas is introduced into the space above the moving substrate 7, and mixed with the atmosphere of the glow discharge generated by a pair of oppositely placed electrodes 12 and 13 to form a plasma-polymerized film 10. EFFECT:The decomposition of the film can be suppressed by dividing the plasma-into two parts, and consequently, the plasma-polymerized film can be produced at a speed >=10 times higher than that of the conventional process.



Also published as:

DJP5018177 (B)

DJP1810730 (C)



Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 昭60-238304

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)11月27日

C 08 F 2/52 C 08 G 85/00 // G 11 B 5/85 7102-4 J 7342-4 J

7314-5D 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

薄膜形成方法 到特 顧 昭59-93409

> 昭59(1984)5月10日 砂出 **933**

79発明 者 篠 原 絋 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

門真市大字門真1006番地

⑪出 願 松下電器產業株式会社 個代 理 弁理士 中尾 敏男

外1名

XIII

1、発明の名称

薄膜形成方法

2、特許請求の範囲

移動する基板上に、少なくともモノマーガスの 無極放電により生じた電離気体を導入し、対向電 極のグロー放電と混合させた状態でプラズマ重合 膜を形成することを特徴とする薄膜形成方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はプラズマ重合膜を連続的に形成する方 法に関する。

従来例の構成とその問題点

有機化合物を使うグロー放電には、条件により 重合膜の形成現象が伴ない、との現象の積極的な 利用が高分子薄膜の一形成手段として位置づけさ れ、医学,工学分野に応用展開の検討が進んでい る。との技術は従来の重合法で得られない重合膜 が得られるととで注目されて研究が進められてい るが、その工業的利用の前提となる薄膜形成速度 の点で難点がある。

第1図は従来使用されている代表的な重合装置 の例である。第1図で1は反応容器、2は高周波 コイル、3は基板、4は基板保持板、5は真空ポ ンプ、のはモノマー導入管である。

との装置では、高周波無極放電を利用しており、 放電電極に直接ブラズマがふれないため、反応容 器を例えば石英ガラスで構成すれば、重合膜に質 **極材料が混入する懸念がなくなるので、半導体工** 菜などの分野を中心によく検討されている。

との方法は、モノマーの使用効率面で優れてい るが、膜形成速度は、例えば、60℃のシリカ基 板上にテトラエトキシシランの重合膜を形成する 場合でも高々150Å/min 程度しか得られず。 磁気テーブの保護膜などの工業規模での応用には、 1 桁膜形成速度を大きくすることが望まれている。 従来法では、高周波電力に応じて膜形成速度が ある程度上昇するが、やがて分解も起るようにな り、重合度が低下し好ましくないため、高速化に 限界があった。

発明の目的

本発明は上記事情に鑑みなされたもので、プラ ズマ重合による薄膜形成速度の高速化をはかるこ とを目的とする。

発明の構成

本発明の薄膜形成方法は、無極放電により発生 せしめた電離気体を対向電極のグロー放電に注入 混合させた状態でプラズマ重合膜を形成すること を特徴とし、膜形成速度を大きくできるものであ る。

実施例の説明

以下図面を参照しながら本発明を説明する。 第2図は本発明の方法を適用して得られる磁気記 録媒体の一例の断面図である。第2図で7は高分 子基板、Bは軟磁性層、Bは垂直磁化膜で10は ブラズマ薫合膜である。

以下の説明で保護膜の形成を行う基板をウェブ と呼ぶ。

第3図はウェブ上に高速でプラズマ薫合膜を形成するのに用いた薄膜形成装置である。

素からなる重合膜を得ることもできる。又、無極 放電に用いる高周波と、対向電極間の放電に用い る交流の周波数の選択により、共振現象に類似し たことが起り、高速化を更に進めることができる などの特徴もある。

以下更に具体的に本発明の一実施例について説明する。

無種放電の反応容器は石英ガラスで、直径20cm,長さ40cmで、外周の高周波コイルは10ターンで、ノズルの位置はコイルの上部とコイルの下部(第3図に示した例)に変化させた。

対向電極は、電極の大きさ25cm角で電極間距離は12cmとした。

真空容器は内容積はO.1 dで、排気系は液体窒 第トラップを用いた油拡散ポンプ系と、油回転ポンプ系を併用した。得られた重合膜形成速度を含め、表にまとめた。

(以下余白)

第3図に於て、11は真空容器、12,13は 放電電優で14は放電電源、15は絶縁導入端子、 16はガス導入ノズルA、17は可変リーク弁A、 18は無極放電容器、19は高周放コイル、20 はガス導入ノズルB、21は可変リーク弁B、 22はウエブで23は送り出し軸、24は巻取り 軸、25は回転ローラ、破線で示した28は、紙 面に垂直な方向に配した排気孔である。

#校	* 1	整合戰形成接股	(A/min)	1800	2050	1950	1800	1750	1900	2020	1980	2400	2250	1600	1500	135	160	170	. 155
	林 卷 器 號 图 次	投入電力 (KW)		60		0.7		ខ ជ		0.9		0 J		8 7		0.7		នប	
		放電機 数 (K R z)		*10} 1356		5 0		S		3.6		1.0		3.0		10		æ	
		導入能	(L'nin) & (KRe)	003		402		201		004		Q01		* 7		0.04		003	
		** * * *		* * 0		7 -7000 907.00		**(0%)		ナフチレン		**		ф 7		サッシャン マッシャン マッシャン		ה ה ה י	
		終入署力 (K W)		1.2		1.2		1.2		1.2		2,		1.2		 		1.2	
	泰	按範疇 致 (K 3 r.)		1356		म इ <u>द्</u>		¥. Ø		기 (20)		¥ ¥		医		્ય જિ		# \$6	
	蜂	(Crysa(17)		£07		900		0.08		300		0.04		0.06		70°C		0.06	
	成. 京	* 1 133		4612-1116	7010=>3h		ビニルトルエン		* + 37 & 8 0 × * * * * * * * *		ν φ		シャイドダイキ		9+3++40 090		አ ስ ሴ አ ፍ		
Ì				Γ	* * * * *												म ऋ छ:		

成の弥砕へのネノト・ガメ等人公案の「盤れ産路炎」1~の上路、下離は格路炎コーッの下部がつビコルネットで発動からめる。在下数をは「銀口両内部等の少、下離は立向機能の今に整存された思の機やボしためる。

36開昭60-238304(3)

表より明らかなように、本発明によれば、モノ マーに依存する度合は小さく、殆んど1500 A/min 以上の従来法の10倍以上の高速成膜が 可能であることが理解できる。

本発明によれば、磁気記録媒体の保護膜として 約100人形成したピリジンの重合膜は、従来法 で得た約300人の膜と、ビデオテーブレコーダ のスチルモードでの耐久性が同等であり、生産性 は更に有利になることが確かめられている。

本発明は他の多くのモノマーについてもその効 果が十分確かめられているものである。

発明の効果

本発明は対向電極によるグロー放電中に、無極 放電による電離気体を導入することで、プラズマ 重合の膜形成速度を従来法の10倍以上に高速化 できるものでその実用的効果は大きい。

4、図面の簡単な説明

第1図は従来用いられたプラズマ重合装置で、 第2図は本発明を用いてできる磁気記録媒体の拡 大断面図、第3回は本発明の実施に利用できるブ

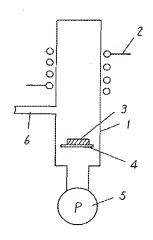
12,13……対向電極。18……反応容器。

19……高剧波コイル。

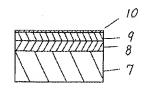
ラズマ重合装置の一例である。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 図



第 2 2



剪 3 5%

